



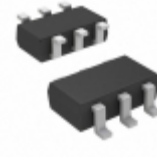


	<h2>SI3475DV-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3475DV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3475DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 13025 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3475DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	13025 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 950mA (Tc) 2W (Ta), 3.2W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	950mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.61 Ohm @ 900mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3475DV-T1-E3TR

SI3475DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3475DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3475DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3475DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3474DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6</p>	 <p><b>SI3476DV-T1-E3</b> VISHAY SI3476DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3476DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 4.6A TSOP-6</p>	 <p><b>SI3475DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3475DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3475DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3474DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6</p>	 <p><b>SI3474DV-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT23-6</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3465DV-T1-E3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3467DV	 SI3467DV-T1-E3
 SI3467DV-T1-E3	 SI3467DV-T1-GE3	 SI3467DV-T1-GE3	 SI3469DV-T1	 SI3469DV-T1-E3
 SI3469DV-T1-E3	 SI3469DV-T1-GE3	 SI3469DV-T1-GE3	 SI3471DV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-E3
 SI3473CDV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-GE3	 SI3473CDV-T1-GE3	 SI3473DDV-T1-GE3	 SI3473DV-T1-E3
 SI3473DV-T1-E3	 SI3473DV-T1-GE3	 SI3473DV-T1-GE3	 SI3474DV-T1-GE3	 SI3474DV-T1-GE3
 SI3475DV-T1-E3	 SI3475DV-T1-GE3	 SI3475DV-T1-GE3	 SI3476DV-T1-E3	 SI3476DV-T1-GE3
 SI3476DV-T1-GE3	 SI3477DV-T1-E3	 SI3477DV-T1-GE3	 SI3477DV-T1-GE3	 SI3481DV-T1-E3
 SI3481DV-T1-E3	 SI3481DV-T1-GE3	 SI3481DV-T1-GE3	 SI3483CDV-T1-E3	 SI3483CDV-T1-E3
 SI3483CDV-T1-GE3	 SI3483CDV-T1-GE3	 SI3483DV-T1-E3	 SI3483DV-T1-E3	 SI3483DV-T1-GE3
 SI3483DV-T1-GE3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3-S	 SI3493BDV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited